
 INITIAL STATE	<h2 style="color: red;">BSC037N08NS5ATMA1</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: BSC037N08NS5ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: Initial State Technologies, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 100A 8TDSO</p> <p>Datenblätter:  BSC037N08NS5ATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC037N08NS5ATMA1
Hersteller	Initial State Technologies, Inc.
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 100A 8TDSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Prüfung	4200pF @ 40V
Spannung - Durchschlag	PG-TDSO-8
VGS (th) (Max) @ Id	3.7 mOhm @ 50A, 10V
Vgs (Max)	6V, 10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	OptiMOS™
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100A (Tc)
Polarisation	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC037N08NS5ATMA1-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Hersteller-Teilenummer	BSC037N08NS5ATMA1
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	58nC @ 10V
IGBT-Typ	±20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.8V @ 72µA
FET-Merkmal	N-Channel
Expanded Beschreibung	N-Channel 80V 100A (Tc) 2.5W (Ta), 114W (Tc) Surface
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 100A 8TDSO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80V
Kapazitätsverhältnis	2.5W (Ta), 114W (Tc)

BSC037N08NS5ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC037N08NS5ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC037N08NS5ATMA1 Initial State Technologies, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSC037N08NS5ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC037N08NS5 INFINEO BSC037N08NS5 INFINEO</p>	 <p>BSC039N06NS INF BSC039N06NS INF</p>	 <p>BSC037N025S G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 100A TDSO-8</p>	 <p>BSC039N06NS3G INFINEO INFINEO TDSO-8</p>
 <p>BSC03N06L35 INFINEO BSC03N06L35 INFINEO</p>	 <p>BSC040N08NS3G INFINEON BSC040N08NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC037N08NS5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A 8TDSO</p>	 <p>BSC037N03MSCG INFINEO BSC037N03MSCG INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC037N08NS5ATMA1 Initial State Technologies, Inc.	BSC037N08NS5ATMA1 Datenblatt	BSC037N08NS5ATMA1-Datenblätter	BSC037N08NS5ATMA1 PDF	Initial State Technologies, Inc. BSC037N08NS5ATMA1
BSC037N08NS5ATMA1 Electronic	BSC037N08NS5ATMA1-Komponenten	BSC037N08NS5ATMA1-Verteiler	BSC037N08NS5ATMA1-Bild	BSC037N08NS5ATMA1-Teil
BSC037N08NS5ATMA1 Preis	BSC037N08NS5ATMA1 Hersteller	BSC037N08NS5ATMA1 Bild	BSC037N08NS5ATMA1 Aktie	BSC037N08NS5ATMA1 Inventar
BSC037N08NS5ATMA1 Neu	BSC037N08NS5ATMA1 Original	BSC037N08NS5ATMA1 garantiert	BSC037N08NS5ATMA1 RFQ	BSC037N08NS5ATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited